Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника» Кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства»

Домашнее задание №1 по дисциплине «Электроника»

Выполнили студенты группы РЛ-41 Филимонов С.В. Мухин Г. А. Сиятелев А.Ю.

Фамилия И.О.

Проверил проф. Крайний В.И.

Оценка в баллах_____

ОГЛАВЛЕНИЕ

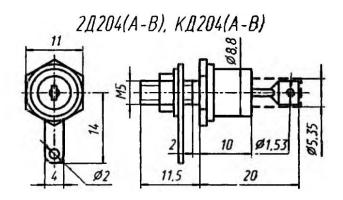
ДИОД		3
1. ИССЛЕДОВАНИЕ СТА ДИОДОВ		ОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 4
, ,	· ·	X ХАРАКТЕРИСТИК 11
		ТИК ПАРАМЕТРОВ 15
, ,	, ,	ДИОДА ПО ДАННЫМ 25
ВЫВОД		33

ДИОД

KD204B

2Д204А, 2Д204Б, 2Д204В, КД204А, КД204Б, КД204В

Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 50 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 6 г, с комплектующими деталями не более 7,5 г.



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение	
при / _{пр} = 0,6 A, не более;	1,4 B
T = +25 °C T = −60 °C	1,4 B
	1,0 6
Импульсное прямое напряжение при	
$h_{\text{NP, M}} = 2 \text{ A}, h_{\text{NP, CP}} = 30 \text{ MA}, f = 1500 \text{ Fu},$	
$t_{\rm H} = 10$ мкс, $t_{\rm h} \le 4$ мкс для 2Д204А, 2Д204Б,	2.0
	2 B
Постоянный обратный ток при $U_{\text{обр}} = U_{\text{обр, макс}}$	
не более:	
T = +25 H -60 °C:	
2Д204А, КД204А	150 MKA
2Д204Б, КД204Б	100 мкА
2Д204В, КД204В	50 MKA
T = +85 °C:	
КД204А	2 MA
КД204Б	
КД204В	0,5 мА
T = +125 °C:	
2Д204А	2 мА
2Д204Б	
2Д204В	
Время обратного восстановления при	man- 000 €1000 00 1980000
$U_{OGP, H} = 30 \text{ B}, I_{OP, H} = 1 \text{ A}, t_{H} = 10 \text{ MKC},$	
	15 440
t_{Φ} ≤ 0,5 мкс, не более	1,5 мкс

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

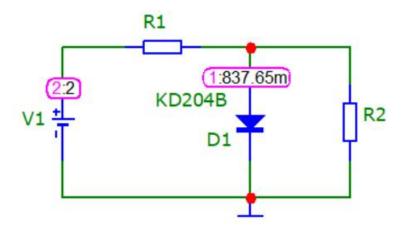


Рис. 1 Схема

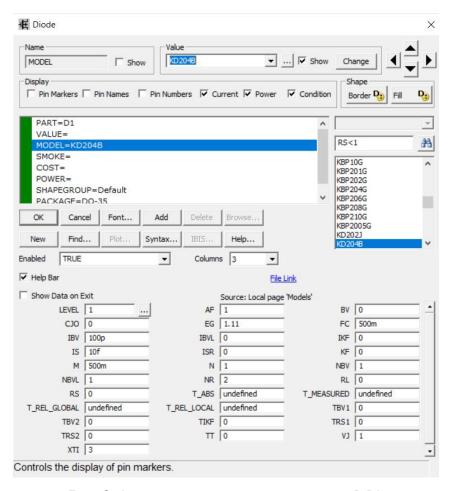


Рис.2 Описание диода в программе МС

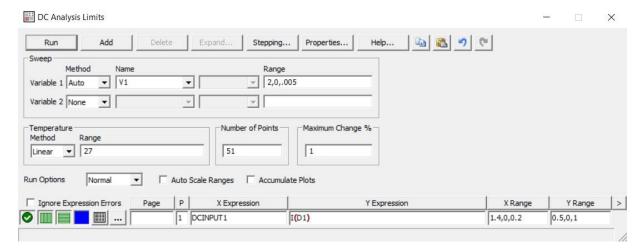


Рис.3 DC Analysyis Limits

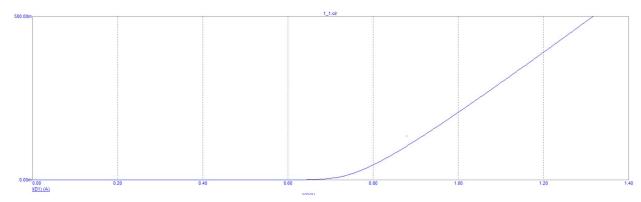
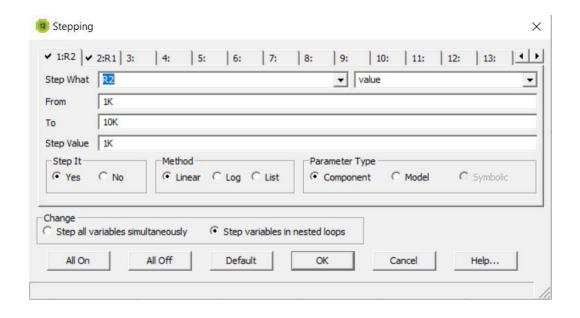


Рис.4 ВАХ прямой ветви

Проводим многовариантный анализ(stepping)для R2 = 1K..10K, R1 = 1..10 Ом.



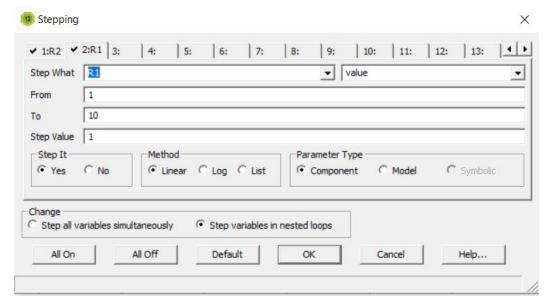


Рис.5 Настройка Stepping

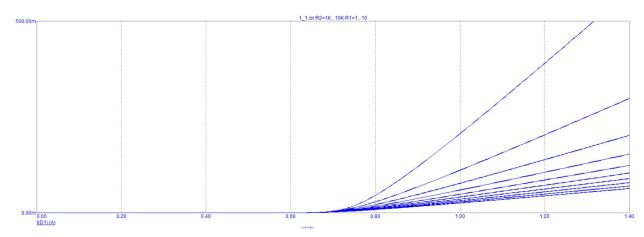


Рис. 6 График ВАХ

Для R1=1..10 Ом. При увеличении величины сопротивления R1 BAX смещается из-за увеличения падения напряжения на R1.

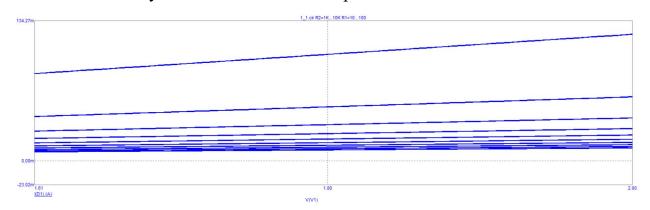


Рис. 7 R1 увеличивается

Графики расположены очень близко друг к другу поскольку сопротивления R2 и диод включены параллельно и $R_{\text{диода}} << R2$.

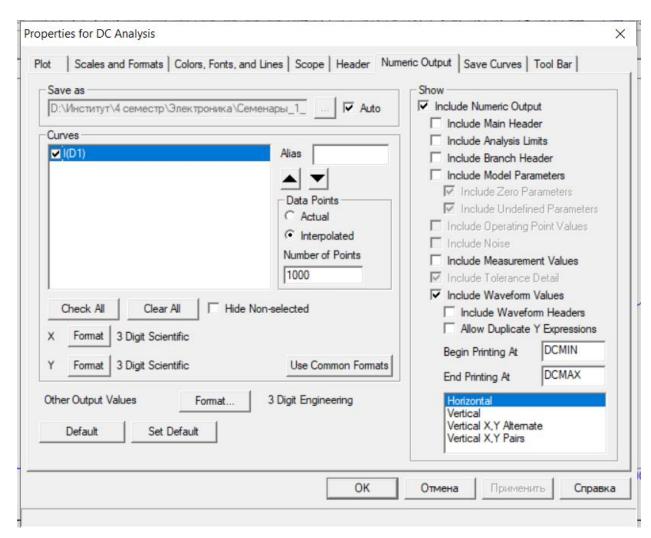


Рис. 8 Настройка для сохранения точек.

V(V1)	I(D1)
	(A)
0.000E+00	1.000E-50
2.002E-03	2.855E-15
4.004E-03	5.711E-15
6.006E-03	8.657E-15
8.008E-03	1.169E-14
1.001E-02	1.473E-14
1.201E-02	1.799E-14
1.401E-02	2.124E-14
1.602E-02	2.465E-14
1.802E-02	2.817E-14
	3.170E-14
2.202E-02	3.555E-14
2.402E-02	3.939E-14
2.603E-02	4.346E-14
2.803E-02	4.771E-14
3.003E-02	5.195E-14
3.203E-02	5.667E-14
3.403E-02	
3.604E-02	6.644E-14
	7.174E-14
4.004E-02	7.705E-14
4.204E-02	8.305E-14
4.404E-02	8.906E-14
4.605E-02	9.554E-14
4.805E-02	1.024E-13

Рис.9 Точки

Rb =
$$1.106$$

Is = $1.331*10^-8$
NFt = 0.044

$$F(x) := x \cdot Rb + \ln\left[\frac{(IS + x)}{IS}\right] \cdot NFt.$$

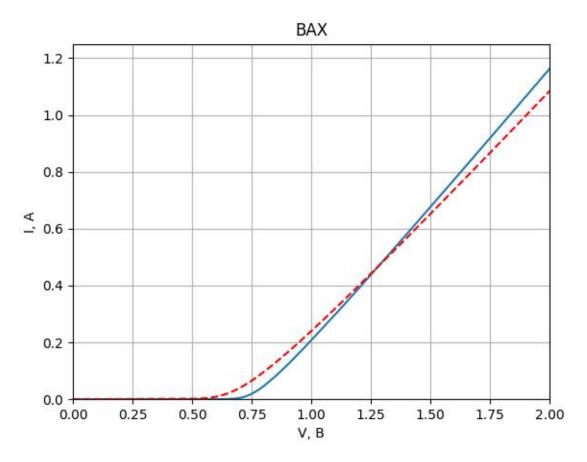


Рис. 10 Вах теоретический

График обратной ветви ВАХ.

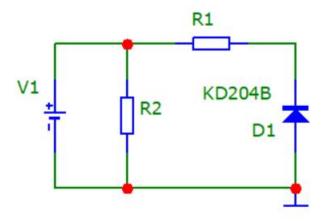


Рис. 1 Схема

Строим обратную ветвь BAX диода. Диалоговое окно задания параметров для построения BAX следующее:

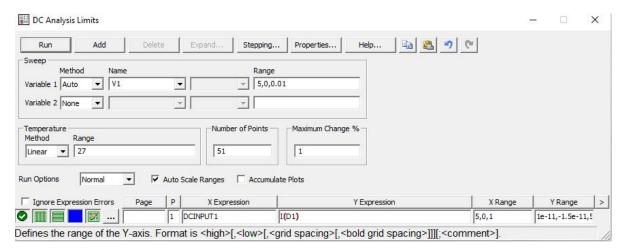


Рис. 2 Настройка пределов

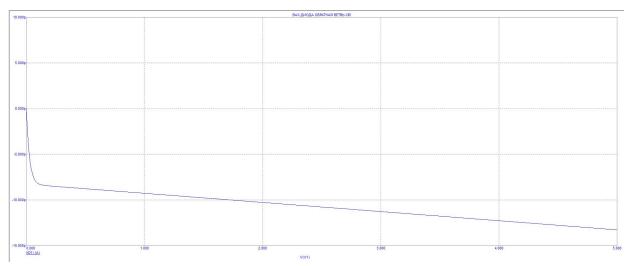


Рис. 3 График обратного ВАХ

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

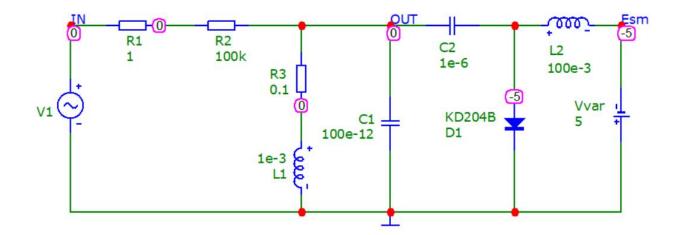


Рис. 1 Схема

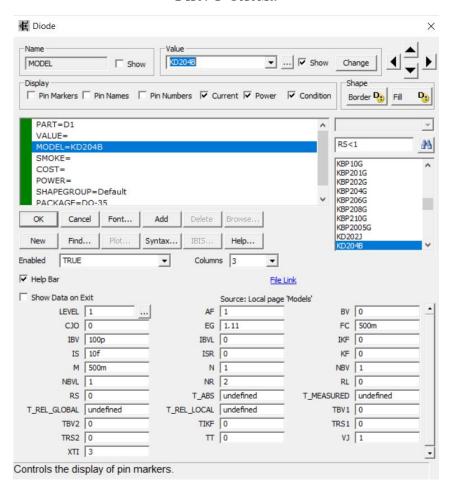


Рис.2 Описание диода в программе МС

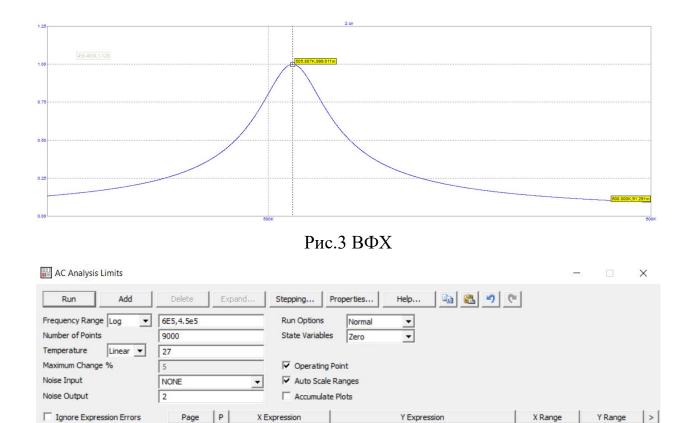


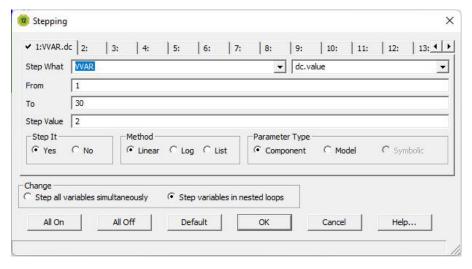
Рис.4 Настройки графика в MC Stepping:

V(OUT)

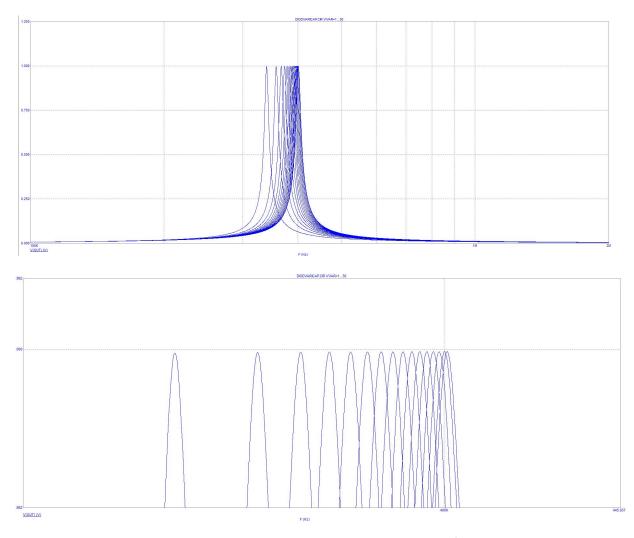
600000,450000,: 1.25,0,0.25

Runs the analysis.

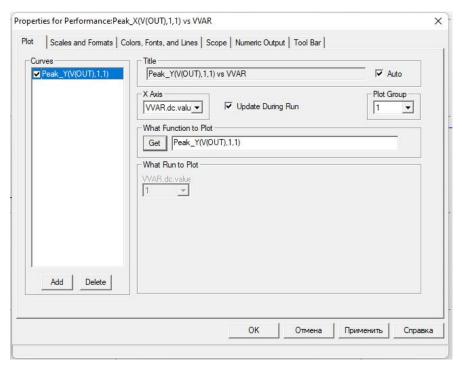
1



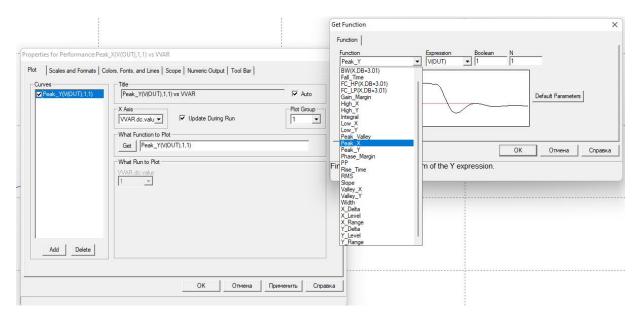
Проведя анализ, получим резонансные кривые:



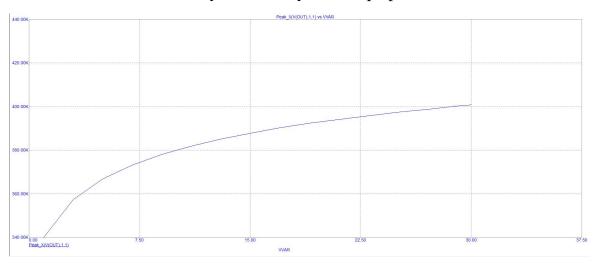
Для построения зависимости резонансной частоты как функцию напряжения источника Vvar выберем AC→Perfomance window→Add performance window.



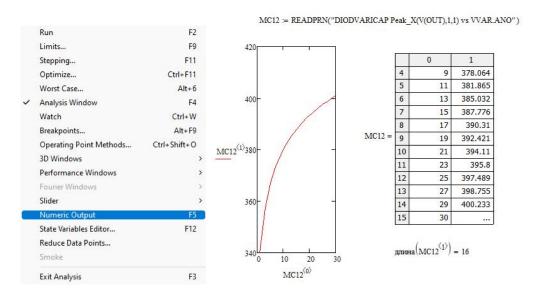
Нажмем Get и выберем в меню Peak_X:



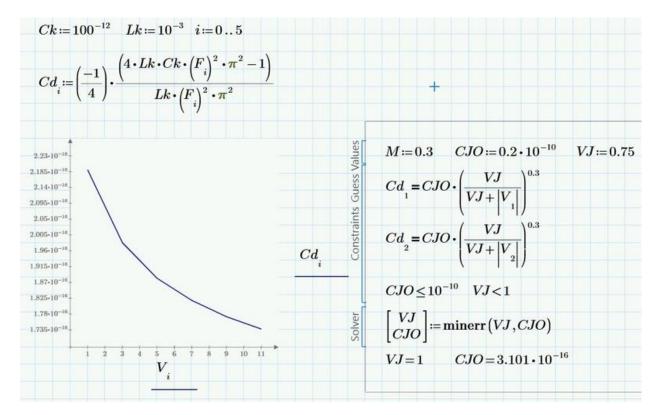
Получаем следующий график:



Вывод данных:



Далее рассчитываем емкость диода и строим график ее зависимости от обратного напряжения (вольт-фарадная характеристика):



ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Цель работы: исследование характеристик германиевого и кремниевого диодов, изучение методики измерения характеристик и расчет параметров математической модели диода по характеристикам.

Приборы и измерительные устройства: Мультиметр М3900, источник питания МАРС, Вольтметр В7-58/2, Резистор сопротивлением 100 кОм и 620 кОм, исследуемые диоды VD1 – Д311A, VD2 – КД105, исследуемый стабилитрон VD3 – Д814A.

Параметры исследуемых элементов:

Д311А:

Диод универсальный германиевый мезадиффузионный.

Постоянное прямое напряжение при $I_{\text{ПР}}$ =10 мA, не более 0,4 В.

Постоянный обратный ток - не более 100 мкА.

Общая ёмкость диода при $U_{\text{обр}} = 5 \; B$, не более $3 \; \text{п} \Phi$.

Предельный постоянный (средний) прямой ток 80 мА.

Предельное постоянное или импульсное обратное напряжение – 30 В.

КД105В:

Диод выпрямительный кремниевый диффузионный.

Среднее прямое напряжение при Іпр=300 мА - не более 1 В.

Средний обратный ток - не более 100 мкА.

Предельный средний прямой ток – 300 мА.

Предельное импульсное обратное напряжение – 600 В.

Примечания.

- 1. Указанные параметры даны для температуры 298 343 К.
- 2. Прямое напряжение указывается для предельного прямого тока, обратный ток —

для предельного обратного напряжения (если не указано иного).

Стабилитрон:

Д814А:

Стабилитрон общего назначения кремниевый сплавной.

Номинальное напряжение стабилизации при Inp=5 MA - 8 B.

Разброс напряжения стабилизации при Іпр=5 Ма – от 7,0 до 8,5 В

Температурный коэффициент напряжения стабилизации при температуре от 303 до

398 К не более 0,07 %/К

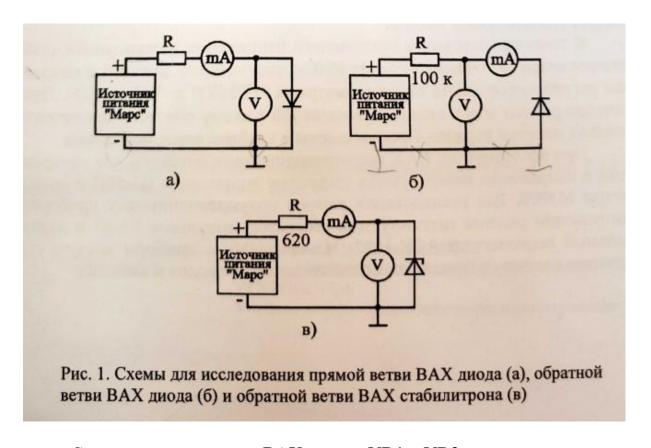
Дифференциальное сопротивление при Іпр=5 Ма - не более 6 Ом.

Постоянное прямое напряжение при Іпр=50 мА - не более 1 В.

Минимальный ток стабилизации – 3 мА.

Максимальный ток стабилизации 40 мА.

Предельный постоянный прямой ток – 100 мА.



Снимаем прямую ветвь BAX диодов VD1 и VD2.

Собираем схему для снятия характеристики; схему на лабораторной установке собрать в соответствии со схемой рис. 1, а. При снятии начального участка прямой ветви ВАХ (токи менее 150 мкА) последовательно с диодом включить резистор 100 кОм. Изменяя выходное напряжение источника питания, последовательно устанавливаем токи диода 50 мкА, 100 мкА, 500 мкА, 1 мА, 2 мА, 5 мА, 7 мА, 10 мА и измерить соответствующие им напряжение на диоде. Для получения токов 500 мкА и больше заменить резистор 100 кОм на 620 Ом, предварительно отключив источник питания (либо уменьшив его выходное напряжение до нуля).

I, mA	U, B
0,05	0,05

0,1	0,10
0,5	0,16
1	0,19
2	0,22
5	0,27
7	0,29
10	0,32

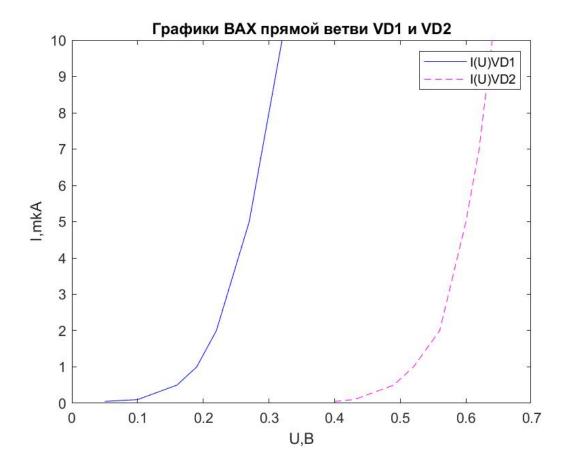
Таблица 1 – Результаты снятия BAX для прямой ветви VD1.

Аналогично снять прямую ветвь BAX диода VD2.

По результатам измерений построить графики прямых ветвей BAX диодов VD1 и VD2 в одной системе координат.

I, mA	U, B
0,05	0,4
0,1	0,43
0,5	0,49
1	0,52
2	0,56
5	0,6
7	0,62
10	0,64

Таблица 2 – Результаты снятия BAX для прямой ветви VD2.



Снимаем обратную ветвь BAX диодов VD1 и VD2.

Собираем схему снятия обратной ветви ВАХ с диодом VD1 (рис. 1, б). Последовательно с диодом включаем резистор 100 кОм. Изменяя выходное напряжение источника напряжения, последовательно устанавливаем напряжения на диоде 0,5 В, 1 В, 2 В, 5 В, 7 В, 10 В и измеряем соответствующие им токи диода.

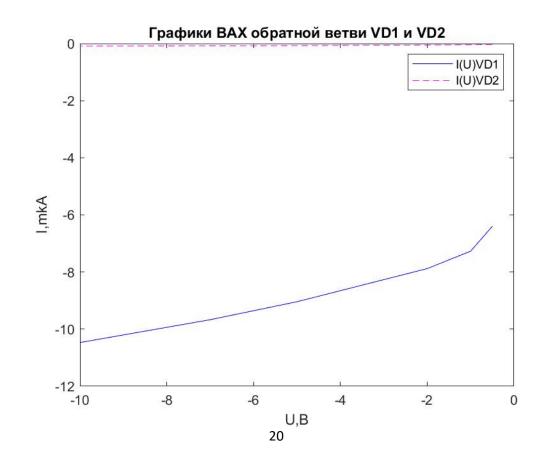
U,B	I,mkA
-0,5	-6,4
-1	-7,27
-2	-7,88
-5	-9,04
-7	-9,67
-10	-10,47

Таблица 3 – Результаты снятия ВАХ для обратной ветви VD1.

Аналогично снимаем обратную ветвь диода VD2. По результатам измерений строим графики обратных ветвей диодов VD1 и VD2 в одной системе координат.

U,B	I,mkA
-0,5	-0,03
-1	-0,04
-2	-0,05
-5	-0,07
-7	-0,08
-10	-0,09

Таблица 4 - Результаты снятия ВАХ для обратной ветви VD2. Построим график:

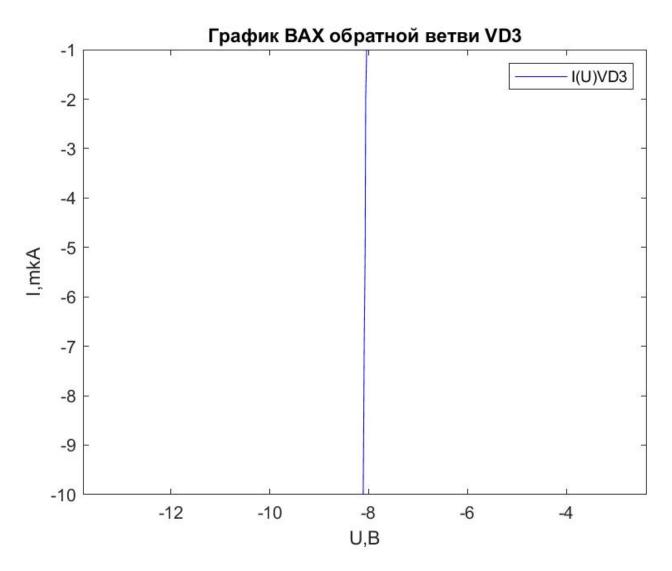


Снимем обратную ветвь ВАХ стабилитрона VD3.

Соберем схему снятия обратной ветви ВАХ стабилитрона VD3 (рис. 1, в).Последовательно со стабилитроном включим резистор 620 Ом. Медленно увеличивая выходное напряжение источника питания, добъемся увеличения обратного тока стабилитрона до 0,5 мА (стабилитрон входит в режим электрического пробоя) и измерим напряжение на стабилитроне. Далее, изменяя выходное напряжение источника питания, последовательно установим токи стабилитрона 1 мА, 2 мА, 5 мА, 7 мА, 10 мА и измерим соответствующие им напряжения на стабилитроне. По результатам измерений построим график обратной ветви ВАХ стабилитрона.

I, mA	U, B
-1	-8,04
-2	-8,06
-5	-8,07
-7	-8,09
-10	-8,11

Таблица 5 – Результаты снятия BAX для обратной ветви VD3.



Определим внутреннее сопротивление измерителя тока для всех использованных при снятии ВАХ пределов измерения.

Для этого из схемы исключим диод, т.е. соберем схему рис. 2, а. Для пределов 20 и 200 мкА последовательно с измерителем тока включим резистор 100 кОм, для остальных пределов – 620 Ом.

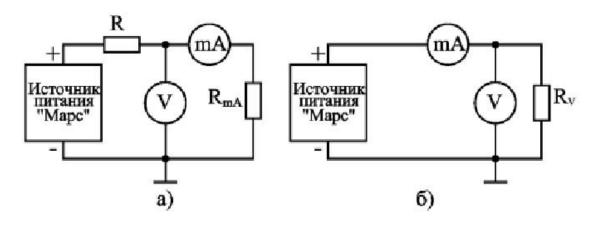


Рисунок 2 – Схемы для определения внутреннего сопротивления миллиамперметра (a) и вольтметра (б).

I, mA	U, B
0,02	0,02
0,2	0,02
10	0,02
20	0,02
30	0,02

Таблица 6 – Результаты снятия BAX схемы для измерения внутреннего сопротивления миллиамперметра.

Определим внутреннее сопротивление вольтметра для всех использованных при снятии ВАХ пределов измерения.

Для этого соберем схему рис. 7. б. Изменяя напряжение источника питания, установим по вольтметру напряжение 10 В (для предела 20 В) или 1 В (для предела 2 В), измерим ток и по результатам измерений определим внутреннее сопротивление вольтметра.

I, mkA	U, B
1	10
0,1	1

Таблица 7 – Результаты снятия BAX схемы для измерения внутреннего сопротивления вольтметра.

Используем формулу для схемы с последовательно включенными

$$I = \frac{U}{R + R_{\mathrm{BH}}}$$
, где R_{BH} — внутреннее сопротивление прибора.

Откуда
$$R_{\text{вн}} = \frac{I}{U} - R.$$

элементами.

Для миллиамперметра:

$$R_{BH}$$
=-99 999,999 O_M

Для вольтметра:

$$R_{BH}$$
=-99 999,9999 O_M

Обработка экспериментальных данных

1. По измеренным ВАХ определить:

1) сопротивление по постоянному току и дифференциальное сопротивление диодов VD1 и VD2 в прямом включении для Iпр= 5 мA;

$$R_D = \frac{U}{I}$$
- сопротивление по постоянному току.

VD1:

 $R_D = 54O_M$

VD2:

 $R_{D} = 120O_{M}$

$$r_D = \frac{dU}{dI}$$
-дифференциальное сопротивление.

VD1:

 $r_D = 16,667O_M$

VD2:

$$r_D = 13,333O_M$$

2) сопротивление по постоянному току и дифференциальное сопротивление диодов VD1 и VD2 в обратном включении для Uобр= -5 B;

VD1:

$$R_D = 553~097~O_M$$

$$r_D=2586206O_M$$

VD2:

$$R_D = 71 \ 428 \ 571 \ O_M$$

$$r_D = 150\ 000\ 000\ O_M$$

3) дифференциальное сопротивление стабилитрона при токах стабилизации 2 мА и 7 мА.

 $r_{D2mA}=20 O_M$

 $r_{D5mA} = 3,33 \text{ Om}$

Выводы по результатам работы:

Мы рассмотрели и сравнили с помощью ВАХ кремниевый и германиевый диоды. Прямые ветви ВАХ имеют похожий вид, однако ВАХ кремниевого диода находится правее ВАХ германиевого диода, что объясняется разной величиной контактной разности потенциалов их р-п-переходов. Типовые значения ф. К для кремниевых р-п-переходов 0,7-0,8 В, для германиевых 0,3-0,4 В, поэтому у кремниевых диодов прямые напряжения оказываются больше, чем у германиевых. Кремниевые диоды имеют обратные токи гораздо меньшие, чем германиевые, а разная форма обратных ветвей их ВАХ объясняется различным соотношением составляющих обратного тока I_T , $I_{T\Gamma}$ и I_y . В германиевых диодах I_T значительно превышает $I_{T\Gamma}$ и I_{y} , поэтому при малых обратных напряжениях $I_{\text{обр}}$ резко возрастает, а далее BAX может идти почти горизонтально. В кремниевых диодах $I_{\text{\tiny TT}} << I_{\text{\tiny TT}}$, поэтому начальный скачок обратного тока мал, а зависимость обратного тока от обратного напряжения проявляется гораздо сильнее, чем в германиевых диодах. При превышении обратным напряжением некоторого предельного значения наблюдается резкое возрастание обратного тока, называемое пробоем р-п-перехода. Для германиевых диодов типичным является тепловой пробой, а для кремниевых диодов – лавинный или (реже) туннельный.

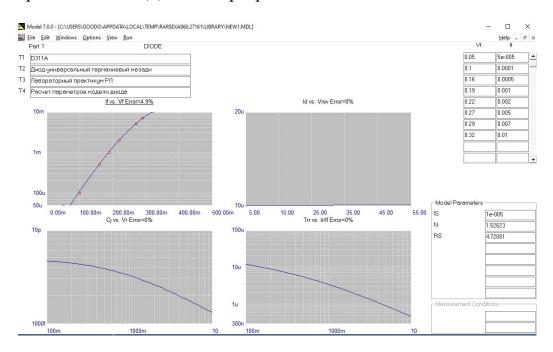
ОПРЕДЕЛИТЬ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ДИОДА ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТА

I, mA	U, B
0,05	0,05
0,1	0,10
0,5	0,16
1	0,19
2	0,22
5	0,27

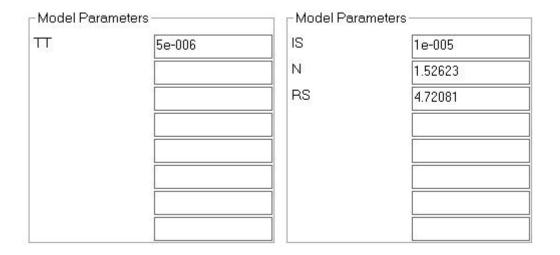
7	0,29
10	0,32

Таблица 1 – Результаты снятия ВАХ для прямой ветви Д311А.

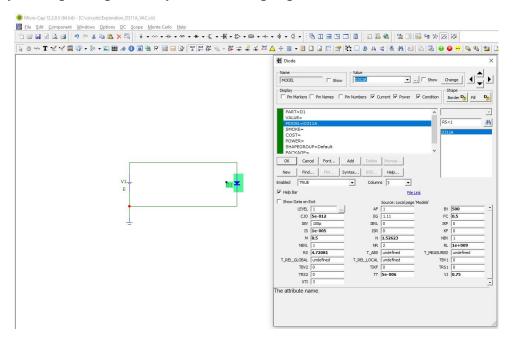
Используя экспериментальные данные из табл. 1 получим характеристики диода Д311A в программе MODEL.



Model Para	meters —	-Model Par	ameters—————
CJO	5e-012	RL	1e+009
М	0.5	BV	500
VJ	0.75		8
FC	0.5		3
EG	1.11		3
XTI	3		
	2		5

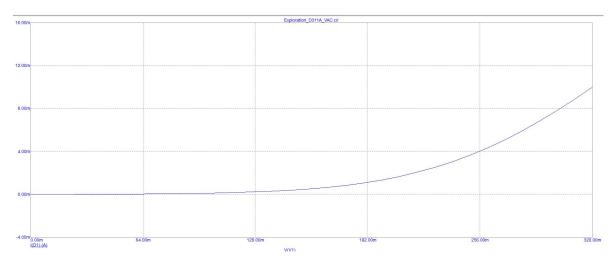


Теперь соберем схему в программе Microcap и в используемом диоде используем параметры, полученные в программе MODEL.

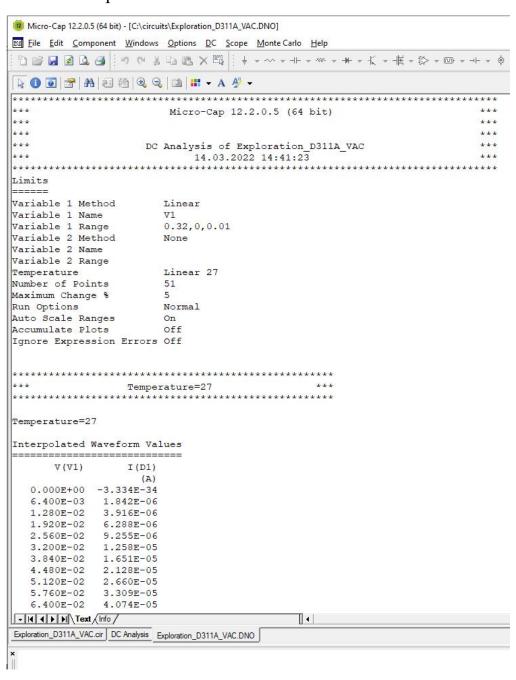


Жирным шрифтом в параметрах диода обозначены те значения, которые были посчитаны в программе MODEL.

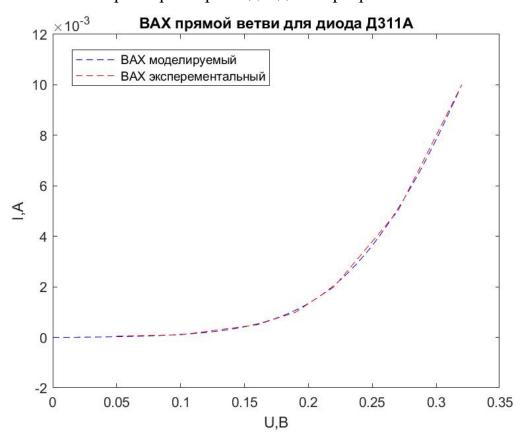
Получим график DC Analysis:



Из этого графика с помощью Numeric Output получим конкретные значения для силы тока и напряжения:



После чего данные из полученного файла табличных значений занесем в MATLAB для построения графика BAX и сравнения экспериментального BAX, полученного на лабораторной работе с BAX, который был построен программой Microcap с параметрами диода из программы MODEL.



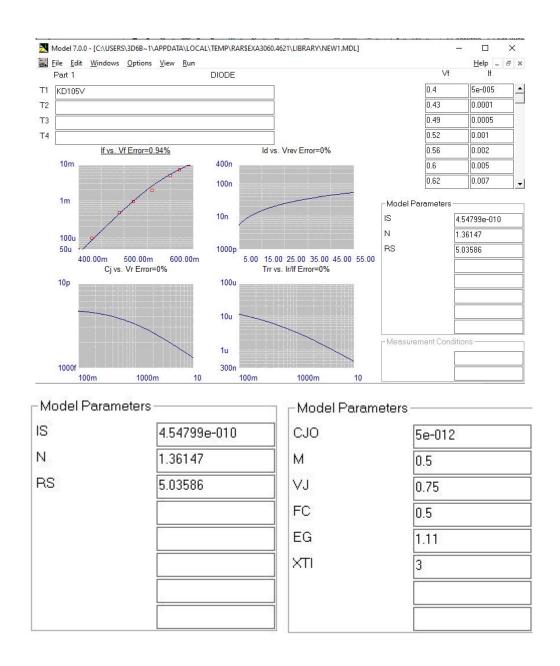
BAX, полученный эксперементально почти не отличается от моделируемого, это может говорить только о высокой точности моделирования программы MODEL.

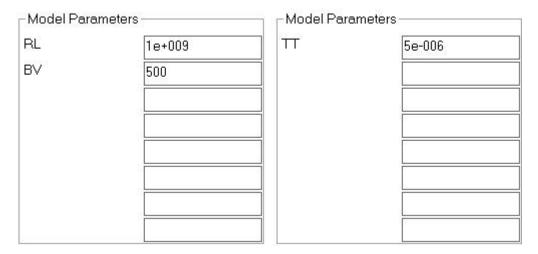
Теперь аналогично первому исследуем второй диод КД105В:

I, mA	U, B
0,05	0,4
0,1	0,43
0,5	0,49
1	0,52
2	0,56
5	0,6
7	0,62
10	0,64

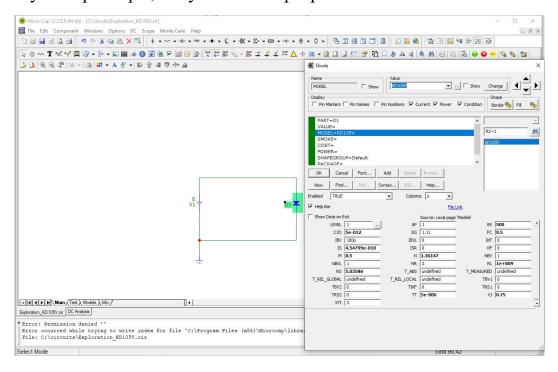
Таблица 2 - Результаты снятия ВАХ для прямой ветви КД105В.

Используя экспериментальные данные из табл. 2 получим характеристики диода КД105В в программе MODEL.

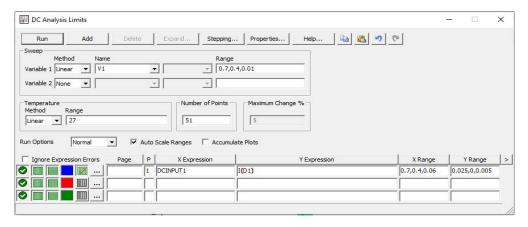




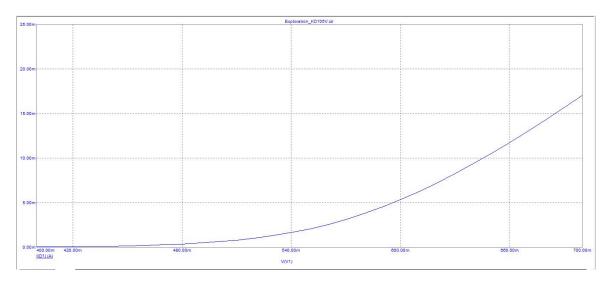
Теперь соберем схему в программе Microcap и в используемом диоде используем параметры, полученные в программе MODEL.



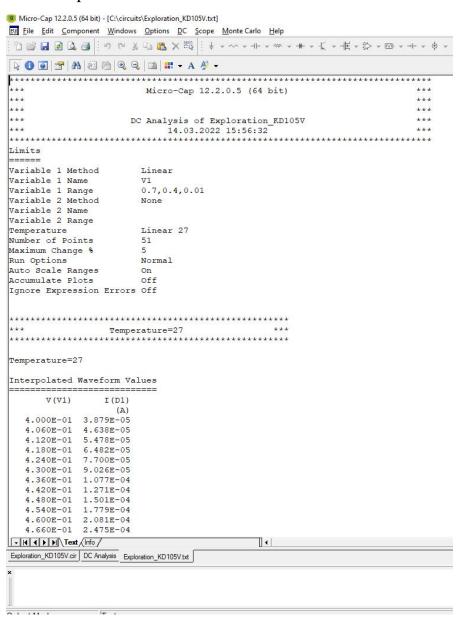
Жирным шрифтом в параметрах диода обозначены те значения, которые были посчитаны в программе MODEL.



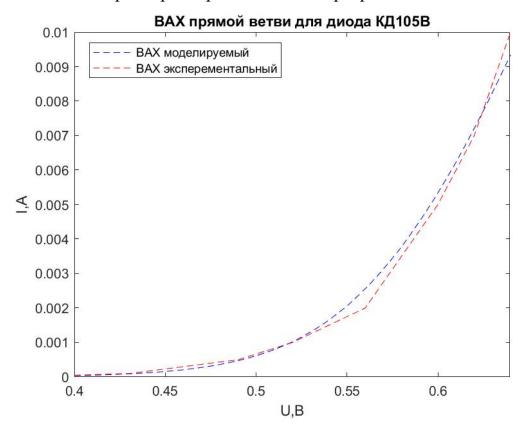
Получим график DC Analysis:



Из этого графика с помощью Numeric Output получим конкретные значения для силы тока и напряжения:



После чего данные из полученного файла табличных значений занесем в MATLAB для построения графика BAX и сравнения экспериментального BAX, полученного на лабораторной работе с BAX, который был построен программой Microcap с параметрами диода из программы MODEL.



ВЫВОД

Мы проделали все 4 семинара первого модуля. В ходе, которых научились работать в команде, в среде Micro-CAP и Multisim, провели анализ кремниевых и германиевых диодов, по построили их математические модели, и различные схемы с ними, а так же изучили их ВАХ.